

**Elektrische Eigenschaften****Electrical properties****Höchstzulässige Werte****Maximum rated values**

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	600, 800	V
Vorwärts-Stoßspitzenspannung	non repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$	1000, 1200	V
Rückwärts-Stoßspitzenspannung	non repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert Dauergrenzstrom	RMS on-state current average on-state current	$t_C = 85^{\circ}\text{C}$ $t_C = 61^{\circ}\text{C}$	$I_{TRMSM}$ $I_{AVM}$	100 46 64	A A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$	$I_{TSM}$	1150	A
Grenzlastintegral	$\int i^2 dt$ -value	$t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\text{ ms}$	$\int i^2 dt$	1000 6600 5000	A A A
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$v_D \leq 67\% V_{DRM}, f_0 = 50\text{ Hz}$	$(di/dt)_{cr}$	120	A/ $\mu$ s
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$v_L = 8\text{ V}, i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 67\% V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	1000	V/ $\mu$ s

**Charakteristische Werte****Characteristic values**

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 150\text{ A}$	$V_T$	max.	1,9	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$		0,95	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$r_T$		4,5	m $\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}$	$i_{GT}$	max.	150	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}$	$V_{GT}$	max.	2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6\text{ V}$	$i_{GD}$	max.	5	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,2	V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}, R_A = 5\Omega$	$i_H$	max.	200	mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{ V}, R_{GK} \geq 20\Omega$	$i_L$	max.	600	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 10\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$	$i_D, i_R$	max.	10	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 0,6\text{ A}, di_G/dt = 0,6\text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{gd}$	max.	1,2	$\mu$ s
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.	$t_q$	typ.	60	$\mu$ s
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	$V_{ISOL}$		2,5	kV

DataSheet4U.com

**Thermische Eigenschaften****Thermal properties**

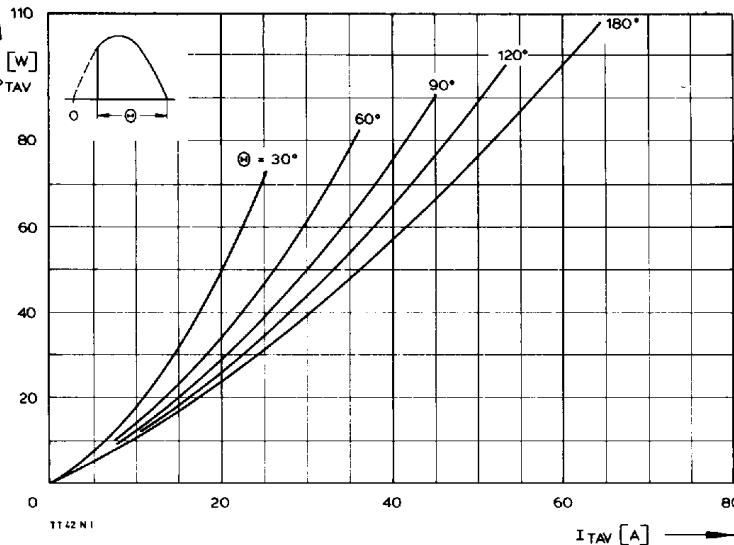
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^{\circ}\text{el}$ , sinus: pro Modul/per module DC: pro Zweig/per arm	$R_{thJC}$	max.	0,3	°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	$R_{thCK}$	max.	0,08	°C/W
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature			$t_{vj\ max}$	125	°C
Betriebstemperatur	operating temperature			$t_{co}$	- 40°C ... + 125°C	
Lagertemperatur	storage temperature			$t_{stg}$	- 40°C ... + 130°C	

**Mechanische Eigenschaften****Mechanical properties**

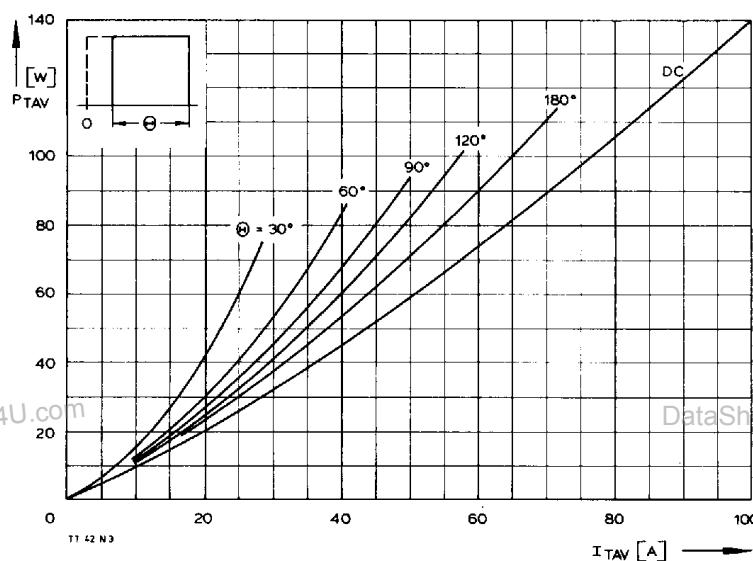
Si-Elemente glaspassiviert, Lötkontakt	Si-pellets glass-passivated, soldered contact					$\text{Al}_2\text{O}_3$
Innere Isolation	internal insulation					
Anzugsdrehmomente	tightening torques					
mechanische Befestigung	mounting torque					
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance $\pm 15\%$		<b>M1</b>	4	Nm
Gewicht	weight	Toleranz/tolerance + 5%/- 10%		<b>M2</b>	4	Nm
Kriechstrecke	creepage distance			<b>G</b>	typ. 160	g
Schwingfestigkeit	vibration resistance				12,5	mm
Maßbild	outline	f = 50 Hz			5 · 9,81	m/s <sup>2</sup>
					1	

www.DataSheet4U.com

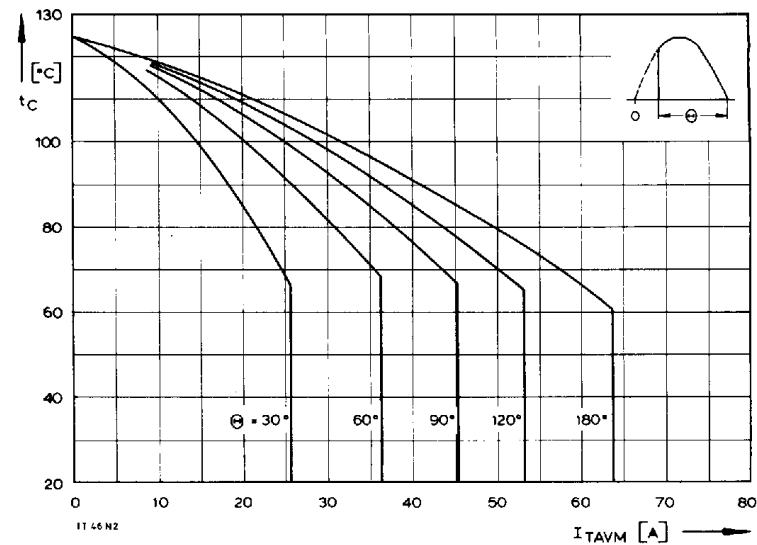
Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.



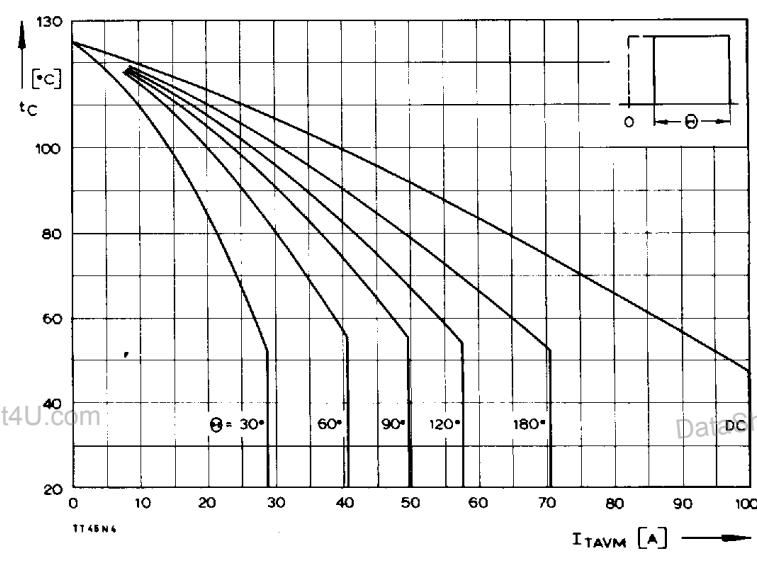
Bild/Fig. 1

Durchlaßverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm  $P_{TAV}$ Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle  $\Theta$ 

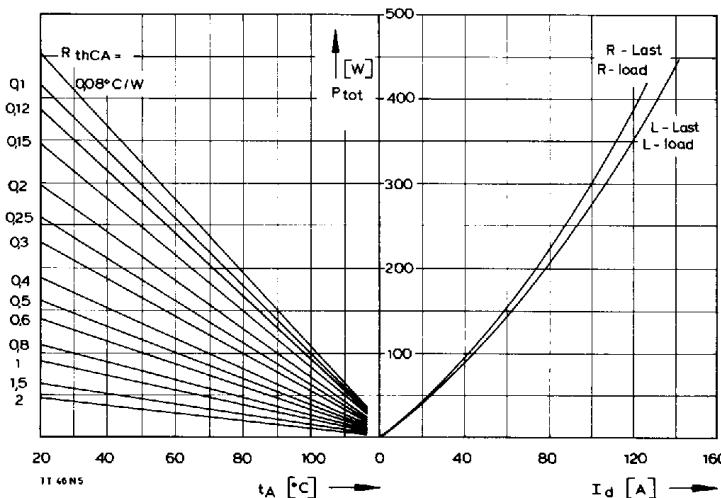
Bild/Fig. 3

Durchlaßverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm  $P_{TAV}$ Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle  $\Theta$ 

Bild/Fig. 2

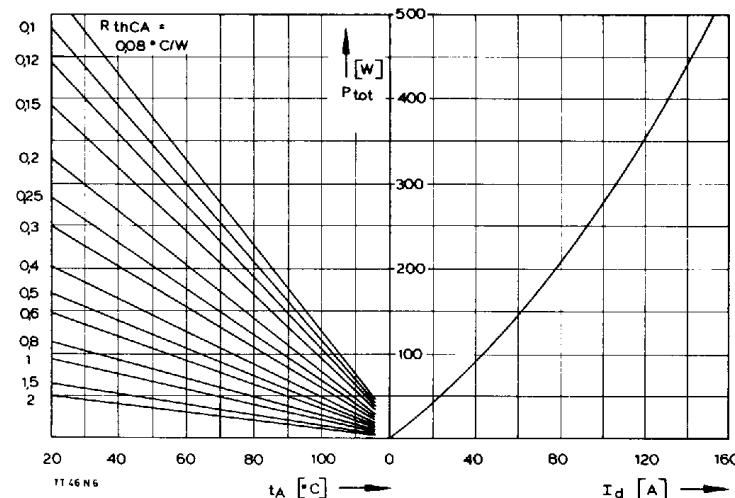
Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_C$  in Abhängigkeit vom ZweigstromMaximum allowable case temperature  $t_C$  versus current per arm

Bild/Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_C$  in Abhängigkeit vom ZweigstromMaximum allowable case temperature  $t_C$  versus current per arm

Bild/Fig. 5

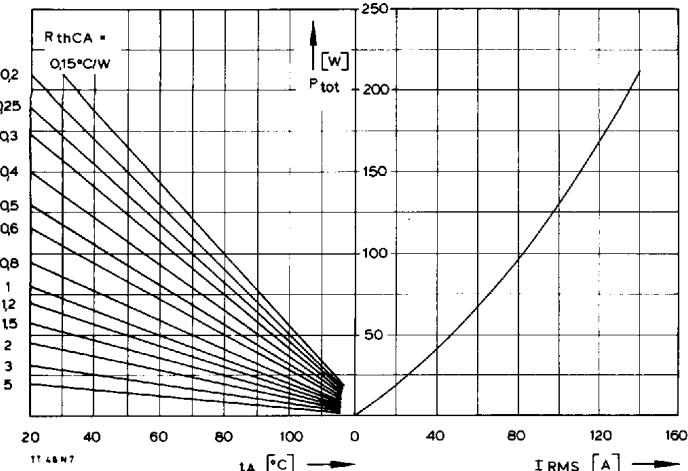
B2 – Zweiipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Höchstzulässiger Ausgangsstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungs-temperatur  $t_A$ .Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$ 

Bild/Fig. 6

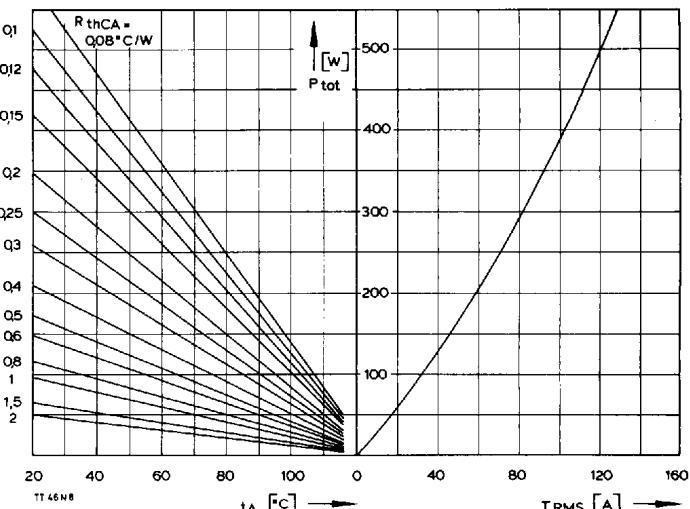
B6 – Sechspuls-Brückenschaltung/Six-pulse bridge circuit

Höchstzulässiger Ausgangsstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungs-temperatur  $t_A$ .Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



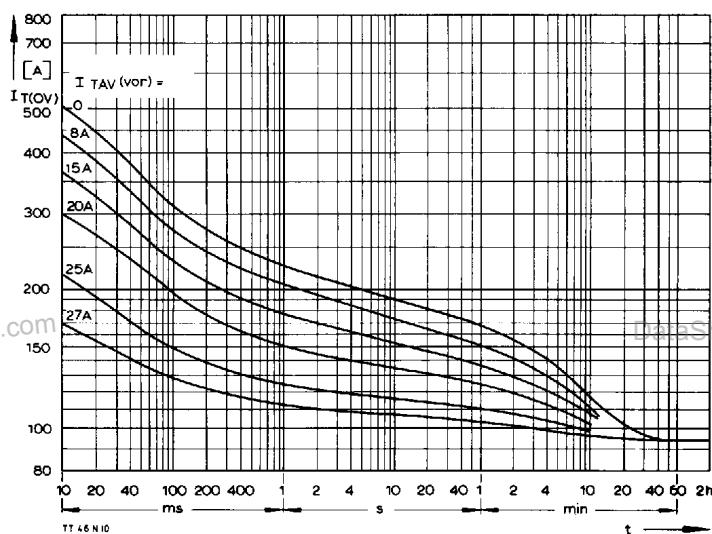
Bild/Fig. 7

W1C – Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit  
Höchstzulässiger Strom  $I_{RMS}$  in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $t_A$ .  
Maximum allowable current  $I_{RMS}$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



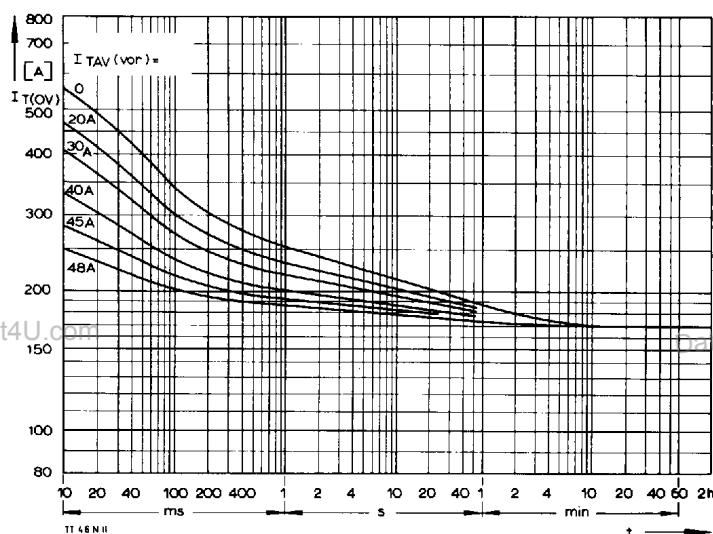
Bild/Fig. 8

W3C – Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit  
Höchstzulässiger Strom je Phase  $I_{RMS}$  in Abhängigkeit von der Umgebungs-  
temperatur  $t_A$ .  
Maximum allowable current per phase  $I_{RMS}$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



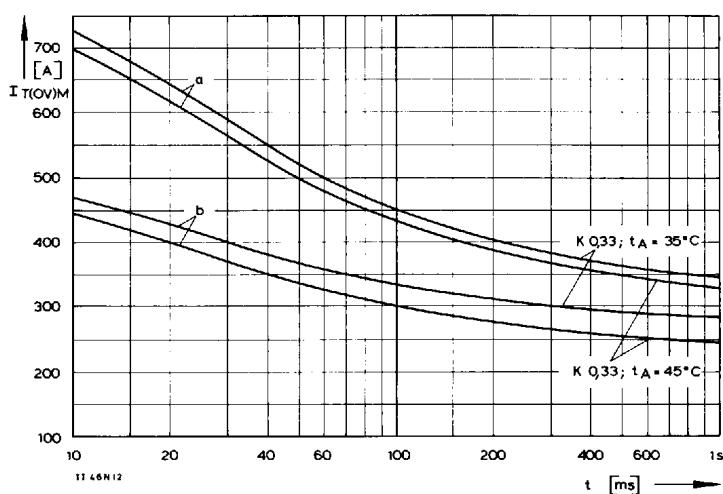
Bild/Fig. 9

B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit  
Überstrom je Zweig  $I_{T(OV)}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A = 45^\circ\text{C}$ , Kühlkörper KP0,33S.  
Overload on-state current per arm  $I_{T(OV)}$  at natural cooling,  $t_A = 45^\circ\text{C}$ ,  
heat sink type KP0.33S.  
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm  $I_{TAV(vor)}$



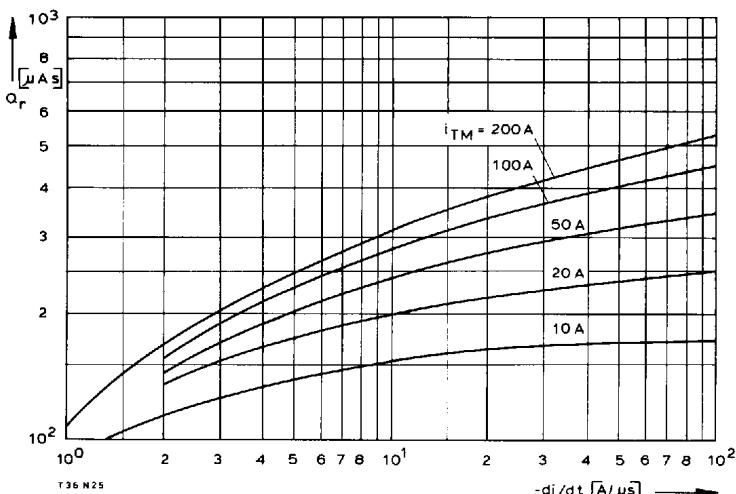
Bild/Fig. 10

B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit  
Überstrom je Zweig  $I_{T(OV)}$  bei verstärkter Luftkühlung,  $t_A = 35^\circ\text{C}$ ,  $V_L = 90 \text{ l/s}$ ,  
Kühlkörper KP0,33S.  
Overload on-state current per arm  $I_{T(OV)}$  at forced cooling,  $t_A = 35^\circ\text{C}$ ,  $V_L = 90 \text{ l/s}$ ,  
heat sink type KP0.33S.  
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm  $I_{TAV(vor)}$



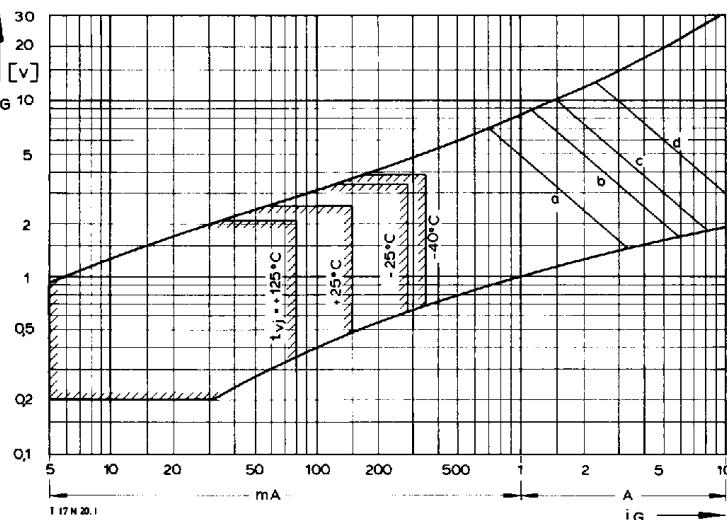
Bild/Fig. 11

Grenzstrom je Zweig  $I_{T(OVM)}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A = 45^\circ\text{C}$  und verstärkter  
Luftkühlung,  $t_A = 35^\circ\text{C}$ , Kühlkörper KP0,33S,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Limiting overload on-state current per arm  $I_{T(OVM)}$  at natural ( $t_A = 45^\circ\text{C}$ ) and  
forced ( $t_A = 35^\circ\text{C}$ ) cooling, heat sink type KP0.33S,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
a – Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions  
b – Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom  $I_{TAVM}$   
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current rating  $I_{TAVM}$



Bild/Fig. 12

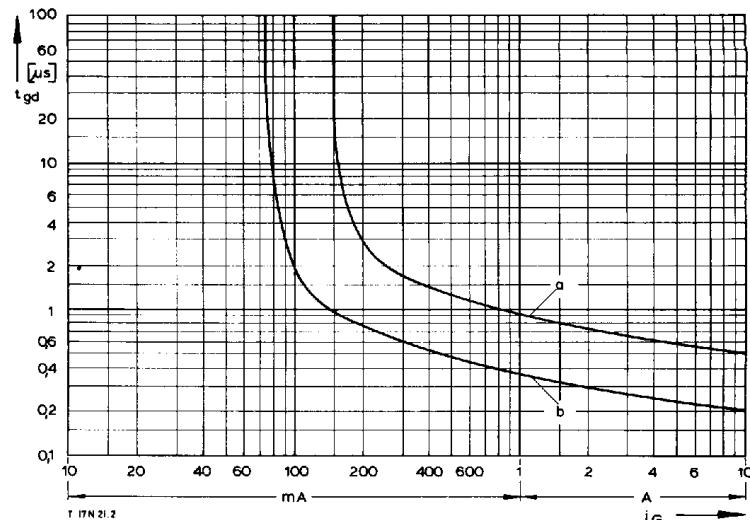
Spererverzögerungsladung  $Q_r$  in Abhängigkeit von der abkommunizierenden  
Stromsteilheit  $-di/dt$  bei  $t_{vj} = t_{vj \max}$ ,  $V_R = 0.5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Der angegebene Verlauf ist gültig für 90% aller Elemente.  
Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current  
 $-di/dt$  at  $t_{vj} = t_{vj \max}$ ,  $V_R = 0.5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
These curves are valid for 90% of all devices.  
Parameter: Durchlaßstrom  $i_{TM}$ /On-state current  $i_{TM}$



Bild/Fig. 13

Zündbereich und Spitzensteuerleistung bei  $v_D = 6 \text{ V}$ .  
Gate characteristic and peak gate power dissipation at  $v_D = 6 \text{ V}$ .

Parameter:	a	b	c	d
Steuerimpulsdauer/Pulse duration $t_g$ [ms]	10	1	0,5	0,1
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/ Maximum allowable peak gate power [W]	5	10	15	30

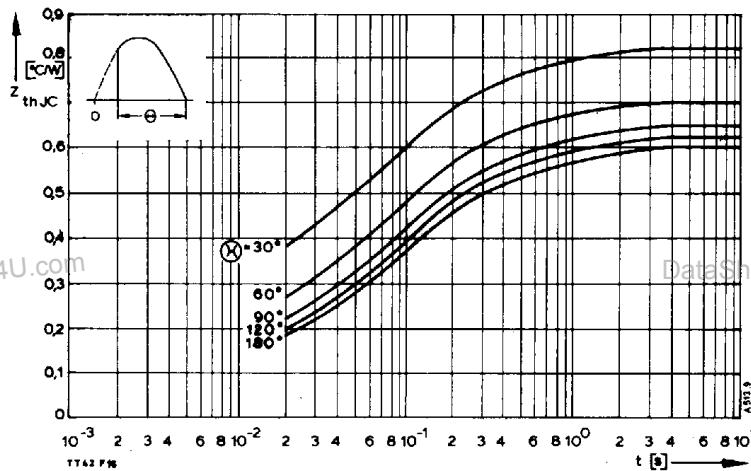


Bild/Fig. 14

Zündverzug/Gate controlled delay time  $t_{gd}$ .

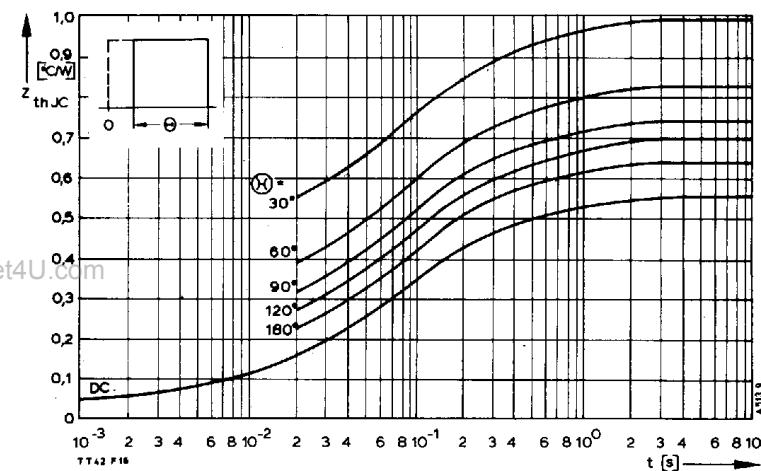
DIN 41787,  $t_a = 1 \mu\text{s}$ ,  $t_{Vj} = 25^\circ\text{C}$ .

- a – äußerster Verlauf/limiting characteristic
- b – typischer Verlauf/typical characteristic



Bild/Fig. 15

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{thJC}$ .  
Transient thermal impedance per arm  $Z_{thJC}$ , junction to case.



Bild/Fig. 16

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{thJC}$ .  
Transient thermal impedance, junction to case, per arm  $Z_{thJC}$ .

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{thn} [\text{°C/W}]$	0,0101	0,0317	0,073	0,144	0,186	0,1152
$\tau_n [\text{s}]$	0,000044	0,00136	0,016	0,065	0,123	0,68

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-t/\tau_n})$$

Transienter Wärmewiderstand  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC.  
Transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC.